



| <b>ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b><br>при температуре (25 ± 5)° С   |                        |          |          |
|--|------------------------|----------|----------|
| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения   | Буквенное обозначение  | Норма    |          |
|  |                        | не менее | не более |
| Выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC}=9,9$ В; $R_L=150$ кОм; $U_{IL}=1,9$ В  | $U_{OL}$               | -        | 0,5      |
| Выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC}=8,1$ В; $R_L=150$ кОм; $U_{IH}=6,3$ В   | $U_{OH}$               | 7,7      | -        |
| Частота следования импульсов тактовых сигналов ,мГц (параметры входного сигнала согласно рис. 5,6), при: $U_{CC}=9,0$ В; $C_H=15$ пФ; $Q=2$                            | $f_C$                  | 2,5      | -        |
| Динамический ток потребления, мА (параметры входного сигнала согласно рис. 5,6), при: $U_{CC}=9,0$ В; $C_H=15$ пФ; $f_C=100$ кГц                                       | $I_{OCC}$              | -        | 0,3      |
| Время задержки распространения сигнала при включении и выключении , нс (параметры входного сигнала согласно рис. 8,9), при: $U_{CC}=9,0$ В; $C_1=15$ пФ; $f_C=100$ кГц | $t_{PHL}$<br>$t_{PLH}$ | -        | 500      |
| Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:<br>- золото<br>- серебро<br>Цветных металлов не содержится.  |                        |          |          |

  

| <b>НАДЕЖНОСТЬ</b>   |
|---|
| <p>Минимальная наработка (<math>T_{nm}</math>) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в следующих облегченных режимах при: <math>U_{CC}=9</math> В минус 10%; <math>C_L</math> не более 25 пФ - 120000 ч.</p> <p>Гамма-процентный ресурс (<math>T_{\gamma}</math>) микросхем при <math>\gamma=95\%</math> 200000 ч</p> <p>Минимальный срок сохраняемости микросхем (<math>T_{см}</math>) при их хранении:<br/> - в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;<br/> - в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;<br/> - под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру ( в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.</p> <p>Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.</p> |
| <b>ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ</b>  |
| <p>Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431200.203 - 05 ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.</p> <p>Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.</p>   |